

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 60-119760

(43)Date of publication of application : 27.06.1985

(51)Int.Cl.

H01L 23/30

H01L 23/00

(21)Application number : 58-227564

(71)Applicant : NITTO ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing : 30.11.1983

(72)Inventor : OMORI SABURO
MOMOTA YASUHITO
IKO KAZUO
ONO HIROBUMI

(54) RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable to clearly see markings with a laser even in a comparatively dark atmosphere by a method wherein a semiconductor element is coat-molded using a resin composition containing a black organic dye of a specific ratio.

CONSTITUTION: A semiconductor device is coat-molded using a resin composition containing a black organic dye of 0.05W3.0wt% in the total composition reference. By this method, the contrast between the surface configurations of broken parts and non-broken parts in markings with a laser becomes clear and the markings are clearly recognized. When the black organic dye to be contained is less than 0.05wt%, the contrast between the broken parts and the non-broken parts is not clear, while when the black organic dye is contained at a ratio of more than 3.0wt%, the moisture resistance of the resin-sealed semiconductor device is made to lower. As a resin, which constitutes the resin composition, is desirable an epoxy resin and an azo-group dye is desirable as the black organic dye.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭60-119760

⑪ Int. Cl.⁴

H 01 L 23/30
23/00

識別記号

庁内整理番号

R-7738-5F
6616-5F

⑬ 公開 昭和60年(1985)6月27日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑭ 発明の名称 樹脂封止半導体装置

⑮ 特 願 昭58-227564

⑯ 出 願 昭58(1983)11月30日

| | | | | |
|---------|------------|-----|---------------|---------------|
| ⑰ 発 明 者 | 大 森 | 三 郎 | 茨木市下穂積1丁目1番2号 | 日東電気工業株式会社内 |
| ⑰ 発 明 者 | 百 田 | 康 仁 | 茨木市下穂積1丁目1番2号 | 日東電気工業株式会社内 |
| ⑰ 発 明 者 | 伊 香 | 和 夫 | 茨木市下穂積1丁目1番2号 | 日東電気工業株式会社内 |
| ⑰ 発 明 者 | 大 野 | 博 文 | 茨木市下穂積1丁目1番2号 | 日東電気工業株式会社内 |
| ⑰ 出 願 人 | 日東電気工業株式会社 | | | 茨木市下穂積1丁目1番2号 |

明 細 書

1. 発明の名称

樹脂封止半導体装置

2. 特許請求の範囲

- (1) 全組成物基準で0.05～3.0重量%の黒色有機染料を含有してなる樹脂組成物を用いて半導体素子を被覆モールドしてなる樹脂封止半導体装置。
- (2) 樹脂組成物がエポキシ樹脂組成物である特許請求の範囲第1項記載の樹脂封止半導体装置。
- (3) 黒色有機染料がアゾ系の合金属化合物である特許請求の範囲第1項又は第2項記載の樹脂封止半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、レーザーにより表面に鮮明なマーキングを施しうる樹脂封止半導体装置に関するものである。

近年、半導体素子をエポキシ樹脂等で封止してなる樹脂封止半導体装置の表面にマーキングする場合に、レーザー発振器から発生するレーザー光を、型抜きしたマスクを通し、その光像を前記半

導体装置上に集束して、所定のマーキングを施すことが一部で実用化されている。このマーキング方式はレーザービームのエネルギーにより樹脂封止半導体装置の表面層を数μの深さに破壊して、表面を粗面化し、この破壊部と非破壊部の表面性状の対比によってマーキングとして視覚的に認識させるものである。しかし、従来の樹脂封止半導体装置においては、この破壊部と非破壊部の対比が必ずしも良好でなく、従って、マーキングが鮮明に見えない問題がある。特に樹脂封止半導体装置の樹脂成形部分が白色、灰色、黒色等の有色の場合、及び比較的暗い雰囲気下でこの傾向が著しい。

本発明は上記に鑑みてなされたものであって、比較的暗い雰囲気下でも、レーザーによるマーキングが明瞭に見える樹脂封止半導体装置を提供することを目的とする。

本発明によると、上記した種々の欠点は、全組成物基準で0.05～3.0重量%の黒色有機染料を含有してなる樹脂組成物を用いて半導体素子を被覆

モールドしてなる樹脂封止半導体装置とすることにより解決できた。

樹脂組成物を構成する樹脂としては、熱硬化性樹脂、特にエポキシ樹脂を挙げることができる。熱硬化性樹脂組成物、特にエポキシ樹脂組成物の場合エポキシ樹脂のほか、通常、硬化剤、硬化促進剤、充填剤、離型剤を含有し、更に必要に応じて、難燃剤、顔料、シランカップリング剤等を含有する。従来、エポキシ樹脂組成物には顔料として金属酸化物、フェロシアン化物等の無機顔料、カーボンブラックが用いられていたが、かかる組成物を用いて封止して得られる樹脂封止半導体装置ではレーザーによる半導体装置表面の破壊部と非破壊部との対比が鮮明でなく、マーキングが明瞭に見えない。

しかし、本発明に従って、樹脂組成物が黒色有機染料を全組成物基準で0.05～3.0重量%含有するとき、レーザーによるマーキングの破壊部と非破壊部との表面性状の対比が鮮明となり、マーキングが明瞭に認められる。特に黒色有機染料が全

してもよい。

本発明で用いる樹脂組成物として特にエポキシ樹脂組成物とするときには、無機質充填剤を、全組成物基準で50～85重量%用いるのが一般的である。

無機質充填剤としては、結晶性シリカ、非晶質シリカ、アルミナ、ガラス繊維、マイカ、タルク、クレー等を挙げることができる。

無機質充填剤としては、好ましくは、粒子径149 μm 以上が0.5重量%以下、46 μm 以下が60～95重量%、10 μm 以下が40～70重量%及び3 μm 以下が15～40重量%である粒度分布を有する。

また本発明で用いる組成物中には、前記した如く硬化剤や、硬化促進剤のほか、必要に応じて難燃剤、離型剤、顔料、シランカップリング剤等を含有してもよい。

本発明においては、樹脂組成物を構成する樹脂としては、エポキシ樹脂が好ましく用いられるが、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、ポリ

組成物基準で0.1～1.0重量%を占めるときにマーキングが著しく鮮明である。

黒色有機染料が0.05重量%以下のときは破壊部と非破壊部の対比が鮮明でなく、一方3.0重量%以上含有すると樹脂封止された半導体装置の信頼性(耐湿性)が低下する等の欠点を有する。

本発明で用いる黒色有機染料としてはアゾ系含金属染料が好ましい。アゾ系の染料としてはモノアゾ系の染料が好適である。

前記染料中に含まれる金属成分としては、銅、カリウム、ナトリウム、クロム、コバルト等を挙げることができるが、特に銅、クロムが好適である。

また、前記染料の金属含有率は0.01～20重量%とされる。

さらに染料の融点は100℃以上分解温度200℃以上のものが望ましい。

なお本発明においては前記黒色有機染料を用いる場合、カーボンブラック、チタン白(酸化チタン)等従来樹脂組成物中に添加される顔料を併用

エステル樹脂、ジアルキルフタレート樹脂、ポリフェニレンサルファイド等も用いられる。これらの樹脂を含む組成物は、その樹脂に応じて所要の添加剤を含有することはいうまでもない。

エポキシ樹脂としてはフェノールノボラックエポキシ樹脂、クレゾールノボラックエポキシ樹脂の如きノボラック型エポキシ樹脂を用いるのが好ましい。

エポキシ樹脂を用いるとき、その硬化剤としては、ノボラック型樹脂(フェノールノボラック、クレゾールノボラック等)、酸無水物系硬化剤(テトラヒドロ無水フタル酸、無水トリメリット酸、無水ベンゾフェノンテトラカルボン酸等)、アミン(ジアミノジフェニルメタン、メタフェニレンジアミン、ジアミノジフェニルエーテル等)等が用いられる。

本発明により得られる樹脂封止半導体装置は、上記構成なので、従来の樹脂封止半導体装置に比して、レーザーによるマーキングが非常に鮮明となる。

本発明の樹脂封止半導体装置をマーキングするときに用いられるレーザーとしては、炭酸ガスレーザー、半導体レーザー、YAGレーザー等を挙げることができる。照射されるレーザーの強さは、通常エネルギー密度0.2~0.5ジュール/cm²である。

なお本発明において、樹脂組成物を用いて、半導体素子を被覆モールドするに当り、予め半導体素子表面にポリイミド系樹脂等による表面保護膜を形成しておくこともできる。

以下に実施例を挙げて本発明を説明する。

実施例1~7、比較例1および2

エポキシ樹脂(エポキシ当量220、軟化点77℃のクレゾールノボラック型樹脂) 16.0部
 ブロム化エポキシ樹脂(エポキシ当量275、軟化点80℃の難燃化樹脂) 2.5部
 フェノールノボラック樹脂(フェノール当量105、軟化点75℃) 8.0部
 硬化剤(2-メチルイミダゾール) 0.4部
 難燃剤(三酸化アンチモン) 1.8部

離型剤(カルナウバワックス) 0.5部
 シランカップリング剤(日本ユニカー社製A-187) 0.5部
 黒色有機染料 (下記第1表に示す)
 無機質充填剤 (下記第1表に示す)

表 1

| 例 | 実施例 | | | | | | 比較例 | |
|----------------------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 残余配合成分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |
| カーボンブラック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAPICO BLACK(チタニウム製) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| OIL BLACK BY() | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| " HBB() | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPILON BLACK RL() | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| " BH() | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORASOL BLACK CN() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.2 | 0 |
| " RL() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| シリカ粉 | 0 | 0 | 70 | 69.8 | 69.3 | 68.8 | 70 | 70 |
| アルミナ粉 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明度(L) | 37 | 37 | 37 | 36 | 38 | 38 | 36 | 26 |
| 色差(ΔE) | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 33 | 10 |

(注)第1表中の数値は明度および色差の値を除いて部を示す。

上記の組成の成形用エポキシ樹脂組成物を調製するに際して、難燃剤と無機質充填剤とをシランカップリング剤で処理した後、残余の材料とこれに加えて粉碎混合し、次に80℃に加熱したミキシングロールにて10分間混合し、シート状に成形し、冷却、粉碎して、樹脂粉末を得た。この成形用粉末を用いてトランスファープレスにて、半導体素子付リードフレームを封止し、表面粗さ12μmの梨地仕上された樹脂封止半導体装置を得た(成形条件—175℃、2分間、トランスファー圧力90kg/cm²と後硬化175℃、10時間)。

得られた半導体装置に炭酸ガスレーザー(渋谷工業(株)製920型レーザーマーク、エネルギー密度最大0.4Joul/cm²)を用いて、100万分の1秒間所定のマスクを通してレーザーを照射して、半導体装置表面にマーキングを施した。

その結果を第1表に併記する。

実施例8~14および比較例3

ビスフェノール型エポキシ樹脂 25.7部
 (エポキシ当量450、軟化点45℃)

上記の組成物より実施例1の方法に準じて樹脂封止半導体装置を作成し、さらに同例に準じて半導体装置表面にマーキングを施した。

その結果を第3表に併記する。

第1表～第3表から明らかなように、本発明の成形用樹脂組成物を用いて得られた成形品は、SMカラーコンピューター（スガ試験機社製）を用いて測定したマーキングの明度および色差共に従来品より優れていることが判る。

以上の如く本発明の樹脂封止半導体装置にレーザーによるマーキングを施すとマーキング性に優れる。

特許出願人

日東電気工業株式会社

代表者 土方 三郎